

“相变存储器规模制造技术关键基础问题研究”项目通过验收

9月30日，国家纳米重大科学研究计划项目“相变存储器规模制造技术关键基础问题研究”课题结题验收会在项目承担单位中国科学院上海微系统与信息技术研究所召开。

中国科学院物理研究所解思深院士、中国科学院上海微系统与信息技术研究所所长王曦院士、北京大学薛增泉教授、中国科学院上海高等研究院院长封松林研究员、南京大学陈坤基教授、上海市科委基础处处长傅国庆、中国科学院前沿科学与教育局技术科学处副处长赵慧斌、中国科学院上海技术物理研究所戴宁研究员、中国科学院上海硅酸盐研究所陈立东研究员、上海科学院闵国全研究员、华东师范大学孙卓教授、上海矽睿科技有限公司总经理谢志峰、中芯国际集成电路制造（上海）有限公司副总裁吴汉明等14位评审专家，科技部基础司重大科学研究计划处杨旭东博士、上海市科学技术奖励中心主任刘海峰、上海市科委基础处副本君、中科院上海微系统所科技部长程建功、项目主管陈华夏以及项目组宋志棠研究员、刘波研究员、詹奕鹏技术总监、陈后鹏研究员、宋三年副研究员、陈一峰博士、陈邦明研究员等共计50余人出席了此次会议。此次验收会议由解思深院士主持。

上海微系统所信息功能材料国家重点实验室主任宋志棠研究员首先欢迎各位专家领导参加此次课题验收会议。杨旭东博士介绍了课题验收的有关要求和规定。赵慧斌讲话，他提出一定要考虑后续的发展方向，有进一步的研究计划，同时要严格遵守国家和科学院关于经费的各项规定，规范使用经费。

傅国庆认为这样的—个基础性课题对大规模制造提供了很好的理论基础，希望各位专家多提宝贵意见，对项目的汇报和未来的发展提供好的建议，上海市科委会一如既往的给予支持。王曦院士代表上海微系统所感谢各位专家参加课题验收会，他表示存储器是半导体行业中的薄弱环节，而我国在存储器领域的力量也是薄弱的，因此要能够将基础研究成果向国内半导体产业界进行转移，课题组通过不懈的努力，在中芯国际的支持下，实现了PCRAM从8寸130nm到12寸40nm节点的发展，是非常了不起的，希望在未来新的存储器领域进一步得到专家和领导的支持。

宋志棠研究员对PCRAM的国际发展趋势及各大公司产品开发的路线作了汇报，明确了PCRAM团队未来的发展重点和方向。刘波研究员对课题目标、研究内容、完成情况做了总体情况汇报。随后与会专家听取了各个方向针对具体情况的详细报告：陈后鹏研究员汇报了PCRAM电路与芯片设计的完成情况；詹奕鹏技术总监汇报了PCRAM芯片单项工艺及其集成技术开发；宋三年副研究员汇报了课题组在自主新材料研发以及自主材料在工程化中的应用；陈—峰博士汇报了PCRAM芯片测试完成情况。

专家组对课题的完成情况和科研成果—点评，并提出了具有针对性的宝贵建议和—指导，要求课题组按照最新的“973”项目验收要求整理项目总结报告、凝练出亮点、突出项目的主线。解思深院士讲到，把企业和研究所结合起来本身就是一种很有特色的产学研用项目组织模式，—定把项目的特点、进展、重大科学贡献和核心技术进步等充分展示出来。薛增泉教授提出要加强与国际大公司相关研究指标的实质性对比，突出基础研究的科学问题和关键技术问题。

最后，专家组认真审查了相关技术文件和资料，认为各项技术指标均全面满足合同书要求，出色完成了预定的研究目标，—致同意项目课题通过验收。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/67793.html>